

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 1 月 18 日 (2007.1.18)

【公開番号】特開 2001-308064 (P2001-308064A)
 【公開日】平成 13 年 11 月 2 日 (2001.11.2)
 【出願番号】特願 2000-127502 (P2000-127502)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/306 (2006.01)

H 0 1 L 21/8242 (2006.01)

H 0 1 L 27/108 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/306 B

H 0 1 L 27/10 6 2 1 C

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 11 月 15 日 (2006.11.15)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体ウェーハ表面上に、複数の種類の薄膜を積層して形成する工程と、
 前記半導体ウェーハ裏面から所定のエッチング薬液を用いたウェットエッチング処理を行い、前記所定のエッチング薬液を前記半導体ウェーハ表面側に回り込ませて、前記半導体ウェーハ表面のエッジ領域における前記複数の種類の薄膜のうち所定の薄膜を選択的に除去する工程と、
 を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

半導体ウェーハを、その裏面を上方に向けて載置するスピチャックと、
該スピチャックの上方に設置され、前記スピチャックに載置された半導体ウェーハ裏面に所定のエッチング薬液を滴下するエッチング薬液供給体とを備えるウェットエッチング装置において、
前記スピチャックの上面に、同スピチャックに載置された半導体ウェーハ表面にガスを吹き付ける孔部が開口された
ことを特徴とするウェットエッチング装置。

【請求項 3】

前記孔部から吹き付けられたガスは、前記半導体ウェーハ表面の中央部から周辺領域に向かって流れる
ことを特徴とする請求項 2 に記載のウェットエッチング装置。